(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-321675 (P2003-321675A)

(43)公開日 平成15年11月14日(2003.11.14)

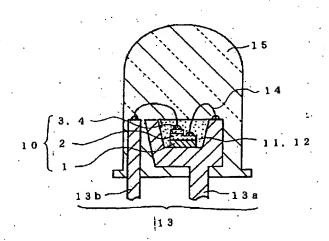
(51) Int.Cl.7		饢別記号	ΡI			· テ	731*(参考)
C09K	11/59	CQH	C 0 9 K	11/59		CQH	4H001
	11/08			11/08		С	5 F 0 4 1
						J	
•	11/62			11/62			
	11/65			11/65			•
		審査請求	水箱 水箱未	表項の数19	OL	(全 21 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顏2002-126566(P2002-126566)	(71)出顧	人 000226	057		
					学工業	株式会社	٠.
(22)出顧日	•	平成14年 4 月26日 (2002. 4. 26)		徳島県	阿南市	上中町岡491都	針地100
			(72)発明	者 玉置	寛人		
				徳島県	阿南市	上中町岡491都	計地100 日亜化
				学工業	株式会	社内	
•			(72)発明	者 亀島	正敏		
	•			· 徳島県	阿南市	上中町岡491都	計地100 日亜化
		•		学工業	株式会	社内	
			(72)発明	者 髙島	優		
				徳島県	阿南市	上中町岡491都	計100 日亜化
				学工業	株式会	社内	
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· .				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 窒化物蛍光体及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 やや赤みを帯びた暖色系の白色の発光装置を 提供すること。また、青色LED等と組み合わせて使用 する黄から赤領域に発光スペクトルを有する窒化物蛍光 体を提供すること。

【解決手段】 青色半導体発光素子10と、その青色半導体発光素子10により励起され黄赤領域に発光スペクトルを有する窒化物蛍光体11と、からなる発光装置であって、前記窒化物蛍光体は、Ca2Si5N7:Euの基本構成元素に、B、Al、Cu、Mn、Mg等を含有する窒化物蛍光体を有している発光装置。



(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.CL7

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-321675 (P2003-321675A)

テーマコート*(参考)

(43)公開日 平成15年11月14日(2003.11.14)

						•	1-1 (5-7)
C 0 9 K	11/59	CQH	C09K	11/59		CQH	4H001
	11/08			11/08		С	5 F 0 4 1
						J	
	11/62	·		11/62			
	11/65			11/65			
		審査請求	未請求 請求	マダイ で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	OL	(全 21 頁)	最終頁に続く
(21)出願番	身	特顯2002-126566(P2002-126566)	(71)出願	ሊ 000226	057		-
				日亜化	学工業	株式会社	
(22) 出顧日		平成14年4月26日(2002.4.%)		徳島県	阿南市	上:中町岡491看	备地100
			(72)発明者	置正 脅	贪人		
				徳島県	阿南市	上中町岡491都	路地100 日亜化
				学工業	株式会	社内	
			(72)発明和	省 龟島	正敏		•
				徳島県	阿南市	上中町岡491都	路地100 日亜化
			1				

FΙ

最終頁に続く

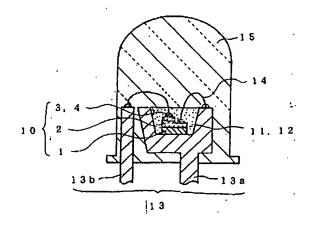
(54) 【発明の名称】 窒化物蛍光体及びその製造方法

識別記号

(57)【要約】

【課題】 やや赤みを帯びた暖色系の白色の発光装置を 提供すること。また、青色LED等と組み合わせて使用 する黄から赤領域に発光スペクトルを有する窒化物蛍光 体を提供すること。

【解決手段】 青色半導体発光素子10と、その青色半導体発光素子10により励起され黄赤領域に発光スペクトルを有する窒化物蛍光体11と、からなる発光装置であって、前記窒化物蛍光体は、Ca2Si5N7:Euの基本構成元素に、B、AI、Cu、Mn、Mg等を含有する窒化物蛍光体を有している発光装置。



学工業株式会社内

学工業株式会社内

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

(72)発明者 高島 優

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の発光スペクトルの少なくとも一部を変換し、前記第1の発光スペクトルと異なる領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有している、基本構成元素に少なくとも窒素を含有する窒化物蛍光体であって、前記窒化物蛍光体は、Lx My N

(2/3×+4/3Y): Z(Lは、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Cd、HgのII価からなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有する。Mは、C、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、HfのIV価からなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有する。Zは、賦活剤である。)で表される基本構成元素を少なくとも含有しており、かつ、Mg、Sr、Ba、Zn、Ca、Ga、In、B、Al、Cu、Mn、Li、Na、K、Re、Ni、Cr、Mo、O及びFeからなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有することを特徴とする窒化物蛍光体。

【請求項2】 前記窒化物蛍光体は、 $L_X M_Y N$ (2/3X+4/3Y): Z (Lは、Mg、Ca、Sr、BaのII 価からなる群より選ばれる少なくとも1 種以上を含有する。<math>Mは、Siである。Zは、賦活剤である。) で表される基本構成元素を少なくとも含有しており、かつ、Mg、Sr、Ba、Zn, B、AI、Cu、Mn、Cr、O及びNiからなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有することを特徴とする請求項1 に記載の窒化物蛍光体。

【請求項3】 前記2で表される賦活剤は、Euであることを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の窒化物蛍光体。

【請求項4】 前記Zで表される賦活剤は、Mn、B、Ce、Mg、Cu、Al及びEuのうち少なくとも1種以上を含有するものであることを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の窒化物蛍光体。

【請求項5】 前記X及びYは、X=2、Y=5であることを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の窒化物蛍光体。

【請求項6】 前記X及びYは、X=1、Y=7である ことを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の窒 化物蛍光体。

【請求項7】 前記Lと前記Zとは、L:Z=1:0. 001 \sim 1のモル比の関係を有することを特徴とする請求項1乃至4の少なくともいずれか一項に記載の窒化物 蛍光体。

【請求項8】 前記窒化物蛍光体は、平均粒径が0.1 ~10μmの大きさであることを特徴とする請求項1乃 至7の少なくともいずれか―項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項9】 前記室化物蛍光体は、黄から赤領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有していることを特徴とする請求項1乃至8の少なくともいずれか一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項10】 前記窒化物蛍光体は、520nmから780nmの波長範囲に前記第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有していることを特徴とする請求項1乃至8の少なくともいずれか一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項11】 Lx My N(2/3X+4/3Y): Z(Lは、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Cd、HgのII価からなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有する。Mは、C、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、HfのIV価からなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有する。Zは、賦活剤である。)で表される基本構成元素を少なくとも含有しており、かつ、Mg、Sr、Ba、Zn、Ca、Ga、In、B、Al、Cu、Mn、Li、Na、K、Re、Ni、Cr、Mo、O及びFeからなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有する窒化物蛍光体の製造方法であって、前記窒化物蛍光体の原料を、アンモニア雰囲気中で焼成が行われる工程を有することを特徴とする窒化物蛍光体の製造方法。

【請求項12】 前記焼成は、窒化ホウ素材質のるつばを用いて焼成が行われていることを特徴とする請求項11に記載の窒化物蛍光体の製造方法。

【請求項13】 第1の発光スペクトルを有する半導体発光素子と、前記第1の発光スペクトルの少なくとも一部を変換し、前記第1の発光スペクトルと異なる領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有している蛍光体と、を少なくとも有する発光装置であって、前記蛍光体には、請求項1乃至10の少なくともいずれか1項に記載の窒化物蛍光体が含有されていることを特徴とする発光装置。

【請求項14】 前記蛍光体には、セリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光物質が含有されていることを特徴とする請求項13に記載の発光装置。

【請求項15】 前記蛍光体に含有されている、前記セリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光物質と前記請求項1乃至10の少なくともいずれか1項に記載の窒化物蛍光体との重量比率は、1~15対1で混合されていることを特徴とする請求項14に記載の発光装置。

【請求項16】 前記第1の発光スペクトルは、360~550nmに発光波長を有しており、前記第1の発光スペクトルの少なくとも一部が変換された光と、前記第1の発光スペクトルの他の一部と、が混合されて放出されることにより白色系の発光が行われることを特徴とする請求項13乃至15の少なくともいずれか一項に記載の発光装置。

【請求項17】 前記蛍光体は、粉体又は粒体であって、光透光性材料に含有されていることを特徴とする請求項13乃至16の少なくともいずれか―項に記載の発光装置。

【請求項18】 前記半導体発光素子は、III族窒化物系化合物半導体発光素子であることを特徴とする請求項13乃至17の少なくともいずれか一項に記載の発光装置。

【請求項19】 前記発光装置は、平均演色評価数Raが75乃至95であり、色温度が2000Kから8000Kであることを特徴とする請求項13乃至18の少なくともいずれか一項に記載の発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ディスプレイ、液晶用バックライト、蛍光ランプ等の照明に使用される発光装置に関する。詳しくは、半導体発光素子(以下、

「LED」という。)と蛍光体とを組み合わせた発光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】LEDは、小型で電力効率が良く鮮やかな色の発光をする。また、LEDランプに用いられるLEDチップは、半導体素子であるため球切れなどの心配がない。さらに初期駆動特性が優れ、振動やオン・オフ点灯の繰り返しに強いという特徴を有する。このような優れた特性を有するため、LEDは、各種の光源として利用されている。

【0003】LEDの光の一部を蛍光体により波長変換 し、当該波長変換された光と波長変換されないLEDの 光とを混合して放出することにより、LEDの光と異な る発光色を発光する発光装置が製造されている。例え ば、白色の発光装置の場合、発光源のチップ表面には、 蛍光体が薄くコーディングされている。該チップは、I nGaN系材料を使った青色LEDである。また、コー ディング層には、(Y, Gd) a (A1, Ga) 5 O 12の組成式で表されるYAG系蛍光体が使われてい る。白色の発光装置の発光色は、光の混色の原理によっ て得られる。チップから放出された青色光は、蛍光体層 の中へ入射した後、層内で何回かの吸収と散乱を繰り返 した後、外へ放出される。一方、蛍光体に吸収された青 色光は励起源として働き、黄色の蛍光を発する。この黄 色光と青色光が混ぜ合わされて人間の目には白色として 見える。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、公知の白色に発光する発光装置は、可視光領域の長波長側の発光が得られにくいため、やや青白い白色の発光装置となっていた。特に、店頭のディスプレイ用の照明や、医療現場用の照明などおいては、やや赤みを帯びた暖色系の白色の発光装置が、強く求められている。また、LEDは、電球と比べて、一般に寿命が長く、人の目にやさしいため、電球色に近い白色の発光装置が、強く求められている。

【0005】従って、本発明は、やや赤みを帯びた暖色

系の白色の発光装置を提供することを目的とする。また、青色LED等と組み合わせて使用する黄から赤領域に発光スペクトルを有する窒化物蛍光体を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、第1の発光スペクトルの少なくとも一部を変換し、前記第1の発光スペクトルと異なる領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有している、基本構成元素に少なくとも窒素を含有する窒化物蛍光体であって、前記窒化物蛍光体は、L_x M_y N

(2/3X+4/3Y): Z(Ld, Be, Mg, Ca、Sr、Ba、Zn、Cd、HgのII価からなる群 より選ばれる少なくとも1種以上を含有する。Mは、 C、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、HfのIV価から なる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有する。 乙 は、賦活剤である。) で表される基本構成元素を少なく とも含有しており、かつ、Mg、Sr、Ba、Zn、C a, Ga, In, B, Al, Cu, Mn, Li, Na, K、Re、Ni、Cr、Mo、O及びFeからなる群よ り選ばれる少なくとも1種以上を含有することを特徴と する窒化物蛍光体に関する。上記基本構成元素及びM n、B等の成分構成元素を少なくとも含有することによ り、発光輝度、エネルギー効率、量子効率等の発光効率 の向上を図ることができる。この理由は定かではない が、上記基本構成元素にMn、B等の成分構成元素を含 有させることにより粉体の粒径が均一かつ大きくなり、 結晶性が著しく良くなるためであると考えられる。結晶 性を良くすることにより、第1の発光スペクトルを高効 率に波長変換し、発光効率の良好な第2の発光スペクト ルを有する窒化物蛍光体にすることができる。また、蛍 光体の残光特性を任意に調整することができる。ディス プレイ、PDP等のように表示が連続して繰り返し行わ れるような表示装置では、残光特性が問題となる。その ため、窒化物蛍光体の基本構成元素に、B、Mg、C r、Ni、Alなどを微量に含有させることにより、残 光を抑えることができる。これにより、ディスプレイ等 の表示装置に本発明に係る窒化物蛍光体を使用すること ができる。このように、蛍光体に含有されている基本構 成元素および成分構成元素を変えることによって、蛍光 体の粒径、結晶性、エネルギー伝達経路が変わり、吸 収、反射、散乱が変化し、発光及び光の取り出し、残光 などの発光装置における発光特性に大きく影響を及ぼす からである。

【0007】前記窒化物蛍光体は、L_x M_y N (2/3x+4/3y): Z(Lは、Mg、Ca、Sr、BaのII価からなる群より選ばれる少なくとも1 種以上を含有する。Mは、Siである。Zは、賦活剤である。)で表される基本構成元素を少なくとも含有しており、かつ、Mg、Sr、Ba、Zn、B、Al、C

u、Mn、Cr、O及びNiからなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有することが好ましい。Lを、Mg、Ca、Sr、Baにすることにより、また、MをSiにすることにより、分解し難い信頼性が高く結晶性の良好な窒化物蛍光体を提供することができるからである。これに伴い、ライフ特性の良好な発光装置を提供することができるからである。この窒化物蛍光体は、第1の発光スペクトルに400~460nmの波長を有する育色LEDを使用して、本発明に係る窒化物蛍光体に照射すると560~680付近にピーク波長を有する、白色に発光する発光装置を製造することができる。

【0008】前記2で表される賦活剤は、Euであることが好ましい。これにより、250~480nm付近の第1の発光スペクトルを吸収し、該吸収により第1の発光スペクトルと異なる領域、特に黄から赤領域に第2の発光スペクトルを有することができるからである。具体的には、460nmに励起された第1の発光スペクトルを窒化物蛍光体に照射すると、580から620nm近傍に最大波長を示す窒化物蛍光体を提供することができるからである。これにより、青色LEDと本発明の窒化物蛍光体とを組み合わせることにより、白色に発光する発光装置を提供することができる。

【0009】前記Zで表される賦活剤は、Mn、B、Ce、Mg、Cu、Al及びEuのうち少なくとも1種以上を含有するものであることが好ましい。これにより、賦活剤にEuのみを用いる場合と異なる領域に最大波長を示す等、発光特性の良い窒化物蛍光体を提供することができるからである。

【0012】前記Lと前記Zとは、L:Z=1:0.001~1のモル比の関係を有することが好ましい。 L_X M_Y $N_{(2/3X+4/3Y)}$:Zで表される基本構成元素中のZの配合割合を上記範囲にすることにより、高輝度の窒化物蛍光体を得ることができる。また、温度特性が良好な窒化物蛍光体を提供することができる。より好ましくは、L:Z=1:0.003~0.05のモル比の関係である。この範囲の時に、高輝度で、温度特性の良好な窒化物蛍光体を提供することができるからである。また、原料のEuの化合物が高価であるため、Euの化合物の配合比率を減少することにより、より低廉な

蛍光体を製造することが可能である。

【0013】前記窒化物蛍光体は、平均粒径が0.1~10μmの大きさであることが好ましい。LEDやLEDランプのような発光装置の場合、最適蛍光膜厚はほぼ平均粒径に比例していて、粒径が小さいほど塗布量は少なくてすむ。その一方、発光効率は一般に大粒径の方が大きい。本発明は、発光輝度、エネルギー効率、量子効率が高い発光特性の良好な窒化物蛍光体を提供できると共に、取り扱いやすく塗布量を少なくすることができる窒化物蛍光体を提供することができる。

【0014】前記窒化物蛍光体は、黄から赤領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有していることが好ましい。青色LEDと黄から赤領域に第2の発光スペクトルを有する窒化物蛍光体とを組み合わせることにより、暖色系の白色に発光する発光装置を提供することができる。

【0015】前記窒化物蛍光体は、520nmから780nmの波長範囲に前記第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有していることが好ましい。400~460nmに励起された紫外又は青色LEDと570nmから730nmの波長範囲に前記第2の発光スペクトルを有する窒化物蛍光体とを組み合わせることにより、暖色系の白色に発光する発光装置を提供することができる。

【0016】本発明は、L_x M_y N

とも含有しており、かつ、Mg、Sr、Ba、Zn、C a, Ga, In, B, Al, Cu, Mn, Li, Na, K、Re、Ni、Cr、Mo、O及びFeからなる群よ り選ばれる少なくとも 1 種以上を含有する窒化物蛍光体 の製造方法であって、前記窒化物蛍光体の原料を、アン モニア雰囲気中で焼成が行われる工程を有することを特 徴とする窒化物蛍光体の製造方法に関する。焼成工程に おいて、還元ガスとして通常水素を数%含む窒素が使用 されるが、水素がるつぼ、炉等を浸食するため、浸食さ れたるつぼ材質が蛍光体組成中に含まれるようになる。 このようなるつぼ材質は、不純物となり、発光輝度、量 子効率、エネルギー効率などの発光効率の低下を引き起 こす原因となる。このため、アンモニア雰囲気中で焼成 を行うことにより、るつぼを浸食せず、不純物を含まな い発光効率の高い蛍光体を製造することができる。ま た、反応性が向上し歩留りが極めて高い蛍光体を製造す

【0017】前記焼成は、窒化ホウ素材質のるつぼを用いて焼成を行うことが好ましい。モリブデンるつぼは、発光を阻害したり、反応系を阻害したりするおそれがあ

ることができる。

る。一方、窒化ホウ素材質のるつぼを使用する場合は、 発光を阻害したり反応系を阻害したりすることがないため、極めて高純度の窒化物蛍光体を製造することができ るからである。また、窒化ホウ素材質のるつばは、水素 窒素中で分解するため、水素窒素雰囲気中での焼成に使 用することができない。

【0018】本発明は、第1の発光スペクトルを有する 半導体発光素子と、前記第1の発光スペクトルの少なく とも一部を変換し、前記第1の発光スペクトルと異なる 領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有して いる蛍光体と、を少なくとも有する発光装置であって、 前記蛍光体には、請求項1乃至11の少なくともいずれ か1項に記載の窒化物蛍光体が含有されていることを特 徴とする発光装置に関する。これにより暖色系の白色に 発光する発光装置を提供することができる。

【0019】前記蛍光体には、セリウムで賦活されたイ ットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光物質が含有され ていることが好ましい。YAG系蛍光物質を含有するこ とにより、所望の発光色に調節することができる。青色 LEDとYAG系蛍光体とを用いた発光装置では、色度 座標X=0.348、Y=0.367、色温度4939 K、肉眼観察で青白い白色の発光が見られる。これに対 して、青色LEDと請求項1乃至11の窒化物蛍光体及 びYAG系蛍光体とを混合した蛍光体とを用いた発光装 置では、色度座標 X=0.454、Y=0.416、色 温度2828K、肉眼観察で暖色系の白色の発光が見ら れる。このように青色LEDと請求項1乃至11の窒化 物蛍光体及びYAG系蛍光体とを混合した蛍光体とを用 いた発光装置を用いることにより、目に優しい暖色系の 白色の発光装置を提供することができる。特に、電球色 の発光装置を提供することができる。また、YAG系蛍 光体に限られず、半導体発光素子と、発光特性の極めて 優れた蛍光体とを組み合わせることにより、背、緑、赤 の他、種々の色を発光することができる発光装置を提供 することができる。

【0020】前記蛍光体に含有されている、前記セリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光物質と前記請求項1乃至11の少なくともいずれか1項に記載の窒化物蛍光体との重量比率は、1~15対1で混合されていることが好ましい。YAG系蛍光体と請求項1乃至11に記載の窒化物蛍光体との配合量を変えることにより、色温度の微調節が可能となる。特に、上記配合比率にすることにより、発光効率が良好なできる。【0021】前記第1の発光スペクトルは、360~550nmに発光波長を有しており、前記第1の発光スペクトルの少なくとも一部が変換された光と、前記第1の発光スペクトルの他の一部と、が混合されて放出されることにより白色系の発光が行われることが好ましい。第1の発光スペクトルにEX=460nmの発光波長を有

する青色LEDを使用することができる他、EX=400nmの発光波長を有する紫外LEDも使用することができる。紫外LEDは、可視光線でないため、電流変化に伴う発光の微小変化を人間(目)が感じることがないため、色変化がない。本発明に係る窒化物蛍光体は、360~480nm辺りの発光波長を吸収するため、EX=400nmの紫外LEDを使用することができる。従って、360~550nm付近の発光波長を有する第1の発光スペクトルを有する白色の発光装置を提供することができる。

【0022】前記蛍光体は、粉体又は粒体であって、光透光性材料に含有されていることが好ましい。これにより、発光色の微調整を容易にでき、発光効率を高めることができる。

【0023】前記半導体発光素子は、III族窒化物系 化合物半導体発光素子であることが好ましい。これによ り、発光輝度を高め、信頼性の高い発光装置を提供する ことができる。本発明に係る窒化物蛍光体で半導体発光 素子の全部又は一部を覆う場合、窒化物蛍光体と半導体 発光素子との境界面に生じる劣化、反発、剥離などの諸 問題を、同一系の材質を用いることで抑えられるからで ある。前記発光装置は、平均演色評価数Raが75乃至 95であり、色温度が2000Kから8000Kである ことが好ましい。これにより暖色系の白色の発光装置を 提供することができる。特に、好ましくは色温度が30 00Kから5000Kであり、電球色の発光装置を提供 することができる。また、特殊演色性R9の値を高くす ることにより赤み帯びた白色の発光装置を提供すること ができる。以上のことから、本発明は、やや赤みを帯び た暖色系の白色の発光装置を提供すること、青色LED 等と組み合わせて使用する黄から赤領域に発光スペクト ルを有する窒化物蛍光体を提供することが可能であると いう技術的意義を有する。

[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る窒化物蛍光体 及びその製造方法、並びに発光装置を、発明の実施の形 態及び実施例を用いて説明する。だたし、本発明は、こ の実施の形態及び実施例に限定されない。

【0025】本発明に係る発光装置は、第1の発光スペクトルを有する半導体発光素子と、前記第1の発光スペクトルの少なくとも一部を変換し、前記第1の発光スペクトルと異なる領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有している蛍光体と、を少なくとも有する発光装置である。具体的な発光装置の一例として、図1を用いて説明する。図1は、本発明に係る発光装置を示す図である。

【0026】発光装置は、サファイア基板1の上部に積層された半導体層2と、該半導体層2に形成された正負の電極3から延びる導電性ワイヤ14で導電接続されたリードフレーム13と、該サファイア基板1と該半導体

層2とから構成される半導体発光索子10の外周を覆うようにリードフレーム13aのカップ内に設けられた蛍光体11とコーティング部材12と、該蛍光体11及び該リードフレーム13の外周面を覆うモールド部材15と、から構成されている。

【0027】サファイア基板1上に半導体層2が形成さ れ、該半導体層2の同一平面側に正負の電極3が形成さ れている。前記半導体層2には、発光層(図示しない) が設けられており、この発光層から出力される発光ピー クは、青色領域にある460 nm近傍の発光スペクトル を有する。この半導体発光素子10をダイボンダーにセ ットし、カップが設けられたリードフレーム13aにフ ェイスアップしてダイボンド (接着) する。ダイボンド 後、リードフレーム13をワイヤーボンダーに移送し、 半導体発光素子の負電極3をカップの設けられたリード フレーム13aに金線でワイヤーボンドし、正電極3を もう一方のリードフレーム13bにワイヤーボンドす る。次に、モールド装置に移送し、モールド装置のディ スペンサーでリードフレーム13のカップ内に蛍光体1 1及びコーティング部材12を注入する。蛍光体11と コーティング部材12とは、予め所望の割合に均一に混 合しておく。蛍光体11注入後、予めモールド部材15 が注入されたモールド型枠の中にリードフレーム13を 浸漬した後、型枠をはずして樹脂を硬化させ、図1に示 すような砲弾型の発光装置とする。

【0028】以下、本発明に係る発光装置の構成部材について詳述する。

【0029】(蛍光体)本発明に係る窒化物蛍光体は、 $L_x M_Y N_{(2/3X+4/3Y)}: Z$ で表される基本構成元素を少なくとも含有しており、かつ、Mg、Sr、Ba、Zn、B、Al、Cu、Mn、Cr、O及び Fe 等からなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有する窒化物蛍光体である。

【0030】Lは、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Cd、HgのII価からなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有するものである。特に、分解し難い信頼性の高い窒化物蛍光体を提供することができることから、Mg、Ca、Sr、Baを用いることが好ましい。これらの構成元素を、1種類のみ用いたものも使用できるほか、該1種類の一部を他の構成元素で置換したものでも良い。

【0031】Mは、C、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、HfのIV価からなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有するものである。特に、MをSiにすることにより安価で結晶性の良好な窒化物蛍光体を提供することができる。

【0032】Zは、賦活剤であり、Eu、Cr、Mn、Pb、Sb、Ce、Tb、Pr、Sm、Tm、Ho、Er、Yb、Ndからなる群より選ばれる少なくとも一種以上を含有する。このうち黄色から赤色領域で発光を行

うEu、Mn、Ce等を用いて本発明を説明するが、これに限定されない。ZにEuを用い、希土類元素であるユウロピウムEuを発光中心とする。ユウロピウムは、主に2価と3価のエネルギー準位を持つ。本発明の窒化物蛍光体は、母体のアルカリ土類金属系窒化ケイ素に対して、Eu²+を賦活剤として用いる。Eu²+は、酸化されやすく、3価のEu²O³の組成で市販されている。しかし、市販のEu²O³では、Oの関与が大きく、良好な蛍光体が得られにくい。そのため、Eu²O³からOを、系外へ除去したものを使用することが好ましい。たとえば、ユウロビウム単体、窒化ユウロビウムを用いることが好ましい。

【0033】窒化物蛍光体には、基本構成元素の他に、Mg、Sr、Ba、Zn、Ca、Ga、In、B、Al、Cu、Mn、Li、Na、K、Re、Ni、Cr、Mo、O及びFeからなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含有する。これらの元素は、粒径を大きくしたり、発光輝度を高めたりする等の作用を有している。また、B、Mg、Cr、Ni、Alは、残光を抑えることができるとういう作用を有している。通常、B、Mg、Cr等の添加物が添加されている。近常、B、Mg、Cr等の添加物が添加されていない蛍光体の方が、添加物が添加されている蛍光体よりも残光を1/10に要する時間を1/2から1/4程度まで短縮することができる。一方、Fe、Moは、発光効率を低下させるおそれがあるため、系外に除去しておくことが好ましい。

【0034】窒化物蛍光体11は、半導体発光素子10 によって発光された青色光の一部を吸収して黄から赤色 領域の光を発光する。この窒化物蛍光体11を上記の構 成を有する発光装置に使用して、半導体発光素子10に より発光された青色光と、窒化物蛍光体の赤色光とが混 色により暖色系の白色に発光する発光装置を提供する。 【0035】特に蛍光体11には、本発明に係る窒化物 蛍光体の他に、セリウムで賦活されたイットリウム・ア ルミニウム酸化物蛍光物質が含有されていることが好ま しい。前記イットリウム・アルミニウム酸化物蛍光物質 を含有することにより、所望の色度に調節することがで きるからである。セリウムで賦活されたイットリウム・ アルミニウム酸化物蛍光物質は、半導体発光素子10に より発光された青色光の一部を吸収して黄色領域の光を 発光する。ここで、半導体発光素子10により発光され た青色光と、イットリウム・アルミニウム酸化物蛍光物 質の黄色光とが混色により青白い白色に発光する。従っ て、このイットリウム・アルミニウム酸化物蛍光物質と 前記窒化物蛍光体とを透光性を有するコーティング部材 と一緒に混合した蛍光体11と、半導体発光素子10に より発光された青色光とを組み合わせることにより暖色 系の白色の発光装置を提供することができる。この暖色 系の白色の発光装置は、平均演色評価数Raが75乃至 95であり色温度が2000乃至8000Kである。特 に好ましいのは、平均演色評価数Ra及び色温度が色度 図における黒体放射の軌跡上に位置する白色の発光装置である。但し、所望の色温度及び平均演色評価数の発光装置を提供するため、イットリウム・アルミニウム酸化物蛍光物質及び窒化物蛍光体の配合量を、適宜変更することもできる。

【0036】(窒化物蛍光体の製造方法)次に、図2を用いて、本発明に係る窒化物蛍光体の製造方法を説明する。

【0037】原料のL及びMg等を粉砕する(P1)。 原料のLは、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、C d、HgのII価からなる群より選ばれる少なくとも1 種以上を含有する。特に、原料のしは、Be、Mg、C a、Sr、Baのグループからなるアルカリ土類金属が 好ましく、さらにアルカリ土類金属単体が好ましいが、 2以上含有するものでもよい。原料のしは、イミド化合 物、アミド化合物などを使用することもできる。また原 料Lには、B、A1、Cu、Mg、Mn、A12O3な どを含有するものでもよい。原料のLは、アルゴン雰囲 気中、グローブボックス内で粉砕を行う。粉砕により得 られたアルカリ土類金属は、平均粒径が約0.1 umか ら15μmであることが好ましいが、この範囲に限定さ れない。Lの純度は、2N以上であることが好ましい が、これに限定されない。より混合状態を良くするた め、金属のL、金属のM、金属の賦活剤のうち少なくと も1以上を合金状態としたのち、窒化し、粉砕後、原料 として用いることもできる。

【0038】原料のSi及びAl等を粉砕する(P 2)。基本構成元素Lx M

 $y N_{(2/3x+4/3y)} : ZOMd, C, Si, G$ e、SnのIV価からなる群より選ばれる少なくとも1 種以上を含有する。原料のMは、イミド化合物、アミド 化合物などを使用することもできる。Mのうち安価で扱 いやすいため、Siを用いて製造方法を説明するが、こ れに限定されない。Si、Si3N4、Si(NH2) 2、Mg2Siなども使用することができる。Al2O 3の他、Mg、金属ホウ化物(CogB、NigB、M o₂B)、酸化マンガン、H₃BO₃、B₂O₃、Cu 2 O、Cu Oなどの化合物も含有されていてもよい。S iも、原料のしと同様に、アルゴン雰囲気中、若しく は、窒素雰囲気中、グローブボックス内で粉砕を行う。 Si化合物の平均粒径は、約0.1μmから15μmで あることが好ましい。Siの純度は、3N以上であるこ とが好ましい。次に、原料のL及びMg等を、窒素雰囲 気中で窒化する(P3)。この反応式を、化1に示す。 Mgは、数 $10\sim1000$ ppmオーダーであるため、 反応式に含めない。

[0039]

【化1】 $3L + N_2 \rightarrow L_3 N_2$ I I 価のしを、窒素雰囲気中、 $600\sim900$ $\mathbb C$ 、約5 時間、窒化する。これにより、Lの窒化物を得ることが できる。Lの窒化物は、高純度のものが好ましいが、市 販のものも使用することができる。

【0040】原料のSi及びAl等を、窒素雰囲気中で 窒化する(P4)。この反応式を、化2に示す。また、 Alも、数10~1000ppmオーダーであるため、 反応式に含めない。

[0041]

【化2】3 $Si+2N_2 \rightarrow Si_3N_4$ ケイ素Sib、窒素雰囲気中、 $800\sim1200$ ℃、約5時間、窒化する。これにより、窒化ケイ素を得る。本発明で使用する窒化ケイ素は、高純度のものが好ましいが、市販のものも使用することができる。

【0042】L及びMg等の窒化物を粉砕する(P5)。L及びMg等の窒化物を、アルゴン雰囲気中、若しくは、窒素雰囲気中、グローブボックス内で粉砕を行う。同様に、Si及びAl等の窒化物を粉砕する(P6)。また、同様に、Euの化合物Eu₂O₃を粉砕する(P7)。基本構成元素L_XM_yN

(P7)。基本構成工業Lx My N (2/3x+4/3y):ZのZは、賦活剤であり、E u、Cr、Mn、Pb、Sb、Ce、Tb、Pr、S m、Tm、Ho、Erからなる群より選ばれる少なくとも一種以上を含有する。Zのうち、赤色領域で発光波長を示すEuを用いて本発明に係る製造方法を説明するが、これに限定されない。Euの化合物として、酸化ユウロピウムを使用するが、金属ユウロピウム、窒化ユウロピウムなども使用可能である。このほか、原料のZは、イミド化合物、アミド化合物を用いることもできる。酸化ユウロピウムは、高純度のものが好ましいが、市販のものも使用することができる。粉砕後のアルカリ土類金属の窒化物、窒化ケイ素及び酸化ユウロピウムの平均粒径は、約0.1μmから15μmであることが好ましい。

【0043】上記原料中には、Mg、Sr、Ba、Zn、Ca、Ga、In 、B 、Al 、Cu 、Mn 、Li 、Na 、K 、Re 、Ni 、Cr 、Mo 、O 及びFeからなる群より選ばれる少なくとも1種以上が含有されている。また、B 、Al 、Mn などの群より選ばれる化合物を以下の混合工程 (P8) において、配合量を調節して混合することもできる。これらの化合物は、単独で原料中に添加することもできるが、通常化合物の形態で添加される。この種の化合物には、 H_3 BO_3 、Cu $_2$ O_3 、 $MgCl_2$ 、 $MgO\cdot CaO$ 、 Al_2 O_3 、金属ホウ化物 (CrB 、 Mg_3 B_2 、 AlB_2 、Mn B) 、 B_2 O_3 、 Cu_2 O 、Cu O などがある。また、Mn 、Al などは、焼成前の原料中に含有されており、原料の一部が置換された化合物もある。

【0044】上記粉砕を行った後、L及びMg等の窒化物、Si及びA1等の窒化物、Euの化合物 Eu_2 O₃等を混合する(P8)。これらの混合物は、酸化されやすいため、Ar雰囲気中、Xは、窒素雰囲気中、Z0

ブボックス内で、混合を行う。最後に、L及びM g 等の 窒化物、S i 及びA l 等の窒化物、E u の化合物E u $_2$ O $_3$ 等の混合物をアンモニア雰囲気中で、焼成する(P $_9$)。焼成により、M $_8$ 、A l 等を含有するL $_8$ S i $_9$ N $_{(2/3x+4/3y)}$:E u で表される蛍光体を得ることができる(P $_1$ O $_2$)。この焼成による基本構成元素の反応式を、化 $_3$ に示す。上述と同様に、M $_3$ 、A $_1$ 、H $_3$ B O $_3$ 等の添加物も、数 $_3$ 0 $_4$ 1 0 0 0 $_4$ p m オーダーであるため、反応式に含めない。

[0045]

【化3】1.97/3 L_3 N_2 + 5/3 Si_3 N_4 + 0.03/2 Eu_2 O_3 → $L_{1.97}$ $Eu_{0.03}$ Si_5 $N_{7.98}$ $O_{0.045}$ ただし、目的とする蛍光体の組成を変更することにより、各混合物の配合比率は、適宜変更することができる。基本構成元素 L_x Si

 $yN_{(2/3X+4/3Y)}:Zは、L_2Si_5N_8:$ Eu、LSi_7N_10:Euが好ましいが、この配合量 に限定されない。

【0046】焼成は、管状炉、小型炉、高周波炉、メタル炉などを使用することができる。焼成温度は、1200から1700℃の範囲で焼成を行うことができるが、好ましくは、1200から1400℃の焼成温度が好ましい。焼成は、徐々に昇温を行い1200から1500℃で数時間焼成を行う一段階焼成を使用することが好ましいが、800から1000℃で一段階目の焼成を行い、徐々に加熱して1200から1500℃で二段階目の焼成を行う二段階焼成(多段階焼成)を使用することもできる。蛍光体11の原料は、窒化ホウ素(BN)材質のるつぼ、ボートを用いて焼成を行うことが好ましい。窒化ホウ素材質のるつぼの他に、アルミナ(Al2O3)材質のるつばを使用することもできる。

【0047】以上の製造方法を使用することにより、目的とする蛍光体を得ることが可能である。

【0048】(半導体発光素子)半導体発光素子10は、III属窒化物系化合物半導体発光素子であることが好ましい。半導体発光素子10は、例えばサファイア基板1上にGaNバッファ層を介して、Siがアンドープのn型GaN層、Siがドープされたn型GaNからなるn型コンタクト層、アンドープGaN層、多重量子井戸構造の発光層(GaN障壁層/InGaN井戸層の量子井戸構造)、Mgがドープされたp型GaNからなるp型GaNからなるpクラッド層、Mgがドープされたp型GaNからなるp型コンタクト層が順次積層されたp型GaNからなるp型コンタクト層が順次積層された積層構造を有し、以下のように電極が形成されている。但し、この構成と異なる半導体発光素子10も使用できる。

【0049】pオーミック電極は、p型コンタクト層上のほぼ全面に形成され、そのpオーミック電極上の一部にpパッド電極3が形成される。

【0050】また、n電極は、エッチングによりp型コンタクト層からアンドープGaN層を除去してn型コンタクト層の一部を露出させ、その露出された部分に形成される。

【0051】なお、本実施の形態では、多重量子井戸構造の発光層を用いたが、本発明は、これに限定されるものではなく、例えば、InGaNを利用した単一量子井戸構造としても良いし、Si、ZnがドープされたGaNを利用しても良い。

【0052】また、半導体発光素子10の発光層は、Inの含有量を変化させることにより、420nmから490nmの範囲において主発光ピークを変更することができる。また、発光波長は、上記範囲に限定されるものではなく、360~550nmに発光波長を有しているものを使用することができる。

【0053】(コーティング部材)コーティング部材12(光透光性材料)は、リードフレーム13のカップ内に設けられるものであり半導体発光素子10の発光を変換する蛍光体11と混合して用いられる。コーティング部材12の具体的材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂などの温度特性、耐候性に優れた透明樹脂、シリカゾル、ガラス、無機バインダーなどが用いられる。また、蛍光体11と共に拡散剤、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウムなどを含有させても良い。また、光安定化剤や着色剤を含有させても良い。

【0054】(リードフレーム)リードフレーム13 は、マウントリード13aとインナーリード13bとか ら構成される。マウントリード13aは、半導体発光素 子10を配置させるものである。マウントリード13a の上部は、カップ形状になっており、カップ内に半導体 発光素子10をダイボンドし、該半導体発光素子10の 外周面を、カップ内を前記蛍光体11と前記コーティン グ部材12とで覆っている。カップ内に半導体発光素子 10を複数配置しマウントリード13aを半導体発光素 子10の共通電極として利用することもできる。この場 合、十分な電気伝導性と導電性ワイヤ14との接続性が 求められる。半導体発光素子10とマウントリード13 aのカップとのダイボンド (接着) は、熱硬化性樹脂な どによって行うことができる。熱硬化性樹脂としては、 エポキシ樹脂、アクリル樹脂、イミド樹脂などが挙げら れる。また、フェースダウン半導体発光素子10などに よりマウントリード13aとダイボンドすると共に電気 的接続を行うには、Ag-エースと、カーボンペース ト、金属バンプなどを用いることができる。また、無機 バインダーを用いることもできる。インナーリード13 bは、マウントリード13a上に配置された半導体発光 素子10の電極3から延びる導電性ワイヤ14との電気 的接続を図るものである。インナーリード13bは、マ ウントリード13aとの電気的接触によるショートを避

けるため、マウントリード13aから離れた位置に配置することが好ましい。マウントリード13a上に複数の半導体発光素子10を設けた場合は、各導電性ワイヤ同士が接触しないように配置できる構成にする必要がある。インナーリード13bは、マウントリード13aと同様の材質を用いることが好ましく、鉄、銅、鉄入り銅、金、白金、銀などを用いることができる。

【0055】(導電性ワイヤ)導電性ワイヤ14は、半 導体発光素子10の電極3とリードフレーム13とを電 気的に接続するものである。導電性ワイヤ14は、電極 3とオーミック性、機械的接続性、電気導電性及び熱伝 導性が良いものが好ましい。導電性ワイヤ14の具体的 材料としては、金、銅、白金、アルミニウムなどの金属 及びそれらの合金などが好ましい。

【0056】(モールド部材)モールド部材15は、半導体発光素子10、蛍光体11、コーティング部材12、リードフレーム13及び導電性ワイヤ14などを外部から保護するために設けられている。モールド部材15は、外部からの保護目的の他に、視野角を広げたり、半導体発光素子10からの指向性を緩和したり、発光を収束、拡散させたりする目的も併せ持っている。これらの目的を達成するためモールド部材は、所望の形状にすることができる。また、モールド部材15は、凸レンズ形状、凹レンズ形状の他、複数積層する構造であっても良い。モールド部材15の具体的材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂、シリカゾル、ガラスなどの透光性、耐候性、温度特性に優れた材料を使

用することができる。モールド部材15には、拡散剤、 着色剤、紫外線吸収剤や蛍光物質を含有させることもで きる。拡散剤としては、チタン酸バリウム、酸化チタ ン、酸化アルミニウム等が好ましい。コーティング部材 12との材質の反発性を少なくするため、屈折率を考慮 するため、同材質を用いることが好ましい。

【0057】以下、本発明に係る窒化物蛍光体、発光装置について実施例を挙げて説明するが、この実施例に限定されるものではない。

【0058】なお、発光特性は、比較例1の輝度を100%とする相対輝度で示す。残光は、励起時の発光強度を基準に、励起停止後、輝度が1/10まで低下するのに要した時間で示す。温度特性は、25℃の発光輝度を100%とする相対輝度で示す。

[0059]

【実施例】<実施例1~6、比較例1~2>表1は、本発明に係る窒化物蛍光体の実施例1~6及び比較例1~2を示す。また、図3乃至5は、実施例2及び3の窒化物蛍光体の発光特性を示したものである。図3は、実施例2及び3の窒化物蛍光体をEx=460nmで励起したときの発光スペクトルを示す図である。図4は、実施例2及び3の窒化物蛍光体の励起スペクトルを示す図である。図5は、実施例2及び3の窒化物蛍光体の反射スペクトルを示す図である。図5は、実施例2及び3の窒化物蛍光体の反射スペクトルを示す図である。図6は、実施例3の窒化物蛍光体の粒径を撮影した写真である。

[0060]

【表1】

				原料		i		結果
	基本模成元素	原料混合比 (Ca/Si/Eu)	その他 元素	焼成パターン	るつぼ 材質	雰囲気	中心粒程 (Dm/ o log)	中心粒径(USあり) (Dm/ σ log)
実施例1	Ca _{1.87} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.83}	1.97/5/0.03	_	1段階 1350℃×5h	BN	пНэ	5.33/0.410	4.69/0.378
実施例2	Ca _{1.90} Si ₆ N ₈ :Eu _{0.91}	1.99/5/0.01	-	1股階 1350℃×5h	BN	NHa	5.61/0.412	4.31/0.415
実施例3	Ca _{1.94} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.96}	1.94/5/0.06	-	1段階 1350°C×5h	BN	NH ₃	5.13/0.366	4.67/0.419
夹施例4	Ca _{1,97} Si ₅ N ₃ :Eu _{0,93}	1.97/5/0.03	-	2段階 800°C×3h、 1350°C×5h	Ви	NН _э	-	-
実施例5	Co _{1.97} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.93}	1.97/5/0.03	В	1段階 1350℃×5h	ви	ΝНа	_	
実施例6	Ca _{1,87} Si ₅ N ₈ :Eu _{0 63}	1.97/5/0.03	A)	1股階 1350℃×5h	Al ₂ O ₃	νн	-	_
比較例1	Ca _{1.97} Si ₈ N ₈ :Eu _{0.63}	1.97/5/0.03	-	1段階 1350℃×5h	Мо	ина	_	· <u>-</u>
比較例2	Ca _{1,07} Si ₅ N ₆ :Eu _{0,63}	. 1.97/5/0.03	Fe	1段間 1350°C×5h	BN	инэ		_

[0061]

		9	6光特性 (460nm))E	度特性((%)
	色調 ×	色調 y	輝度 (%)	量子効率 (%)	ピーク波長 (nm)	100°C	200℃	300¢C
実施例1	0.583	0.406	135.5	139.0	612	93.7	67,1	23.5
実施例2	0.583	0.410	97.6	96.5	610	99.8	81.1	37.1
実施例3	0.590	0.401 -	139,4	148.0	614	92.9	56.1	12.5
実施例4	0.584	0.400	128.7	136.8	612	97.7	70.6	22.6
実施例5	0.587	0.405	137.6	141,1	612	95.8	65.8	21.6
実施例6	0.586	0.406	116,1	119,1	611	95.7	68.1	22.6
比較例1	0,581	0.410	100,0	100.0	610	97.9	72.7	25.7
比較例2	0.58	0,411	65.1	65.4	611	99.6	79.6	29.6

[0062]

							化与	分析							
	Ca(%)	Eu(\$)	M(X)	O(%)	Fe (ppm)	Mg (ppm)	Sr (ppm)	Ba (ppm)	Zn (ppm)	. 8 (ppm)	A) (ppm)	Mo (ppm)	Mn (ppm)	Cu (ppm)	Si
実施例 :	23.1	1.22	29.4	0.87	7	7	180	1	9	(1	110	(1	(1	(1	全量を100 とした残量
実施例2	23.7	0.48	31.3	1.35	8	13	70	6	360	<1	30	C 1	1	(1	全量を100 とした残量
実施例3	22.4	2.40	31.5	0.97	8	15	50	6	3	<1	30	<1	1	1	全量を100 とした残量
実施例4	23.2	1.20	29.3	0.80	7	8	150	5	5	<1	90	(1	1	4 1	全量を100° とした残量
実施例5	23.1	1,21	29.3	0.90	9	7	110	6	7	510	100	<1	(1	(1	全量を100 とした残量
実施例G	23.0	1.21	29.3	0.95	9	10	120	6	4	<1	90	<1	1	·(1	全量を100° とした発量
比較例1	23.1	1.22	29.4	0.85	9	8	120	5	4	۲۱	30	490	1	Ĭ.	全量を100 とした残量
比較例2	23.1	1.22	29.3	0.98	480	8	140	6	5	d	90	< 1	1	1	全量を100° とした残量

【0063】実施例1~6は、本発明に係るL_X M_Y N (2/3X+4/3Y): ZEB, A1, Cu, Mn, Co、Ni、Mo、O及びFeからなる群より選ばれる 少なくとも1種以上を含有する窒化物蛍光体の化学的特 性や物理的特性を調べた結果である。窒化物蛍光体Lx My N_(2/3 X + 4/3 Y) : Zの基本構成元素のし にはCaを、MにはSiを、ZにはEuを用いて、Ca 2-t Eut Si₅ N₈ で表す。実施例1~6の窒化物 蛍光体に用いられるCaの一部をEuで置換しており、 Euの配合割合をt、Caの配合割合を2-tに表した ものである。Siの5に対して、実施例1は、O.O 3、実施例2は、0.01、実施例3は、0.06で表 される配合割合のEuを含有している。Mg、Sr、B · a、Zn、B、Al、Cu、Mn及びFeのうち少なく とも1種以上が数ppmから数百ppm含有された窒化 カルシウム、窒化ケイ素、酸化ユウロピウムを、窒素雰 囲気中、グローブボックス内で混合する。実施例1にお いて、原料の混合比率 (モル比)は、窒化カルシウムC a₃ N₂: 窒化ケイ素Si₃ N₄: 酸化ユウロピウムE

 $u_2 O_3 = 1.97:5:0.03$ である。 窒化カルシウム $Ca_3 N_2 14.47g$ 窒化ケイ素 $Si_3 N_4 34.75g$ 酸化ユウロピウム $Eu_2 O_3 0.79g$

上記化合物を混合し、焼成を行う。焼成条件は、アンモニア雰囲気中、窒化ホウ素るつぼに投入し、室温から約5時間かけて徐々に昇温して、約1350℃で5時間、焼成を行い、ゆっくりと5時間かけて室温まで冷却した。

【0064】表1より、実施例1の窒化物蛍光体には、基本構成元素の他に、Oが0.87重量%、そして、Mg、Sr、Ba、Zn、B、Al、Cu、Mn及びFeが数ppm濃度含有されている。Siは、100から上記構成元素を差し引いた重量%が含有されている。この焼成条件及びMg、Sr、Ba、Zn、B、Al、Cu及びMnにより高い発光輝度を有する。一般に使用されている半導体発光素子は100~150℃まで温度上昇するため、発光素子の表面に窒化物蛍光体を形成しようとする場合、該温度で安定であることが好ましく、本実

施例1乃至6の窒化物蛍光体の温度特性は極めて良好である。この観点から実施例2は、極めて温度特性が良好であるため、優れた技術的意義を有する。

【0065】実施例3は、実施例2と比較すると発光輝度が高く、量子効率も高い。従って、実施例3は、極めて良好な発光特性を示す。

【0066】実施例1の粒径は1~3μmと粒径が大きく発光輝度も高い。また、分散性も良く扱いやすい。

【0067】実施例4は、焼成条件を変えて原料の焼成 を行った。2段階焼成であっても、実施例4は、実施例 1及び3と同様、高輝度、高量子効率、良好な温度特性 を示す。実施例に係る蛍光体は、窒化ホウ素材質のるつ ぼを用い、アンモニア雰囲気中で焼成を行っている。こ の焼成条件下では、炉及びるつぼが浸食されることはな いため、焼成品に不純物が混入することはない。実施例 5は、原料にBを含有させ焼成した場合の発光効率を示 している。実施例5の結果から、Bが多く含まれていた 場合であっても、発光効率は極めて高い状態を維持して いる。このことは、炉及びBNるつぼが浸食され蛍光体 中にBNが含有した場合を想定したものであるが、発光 効率は低下していないので炉及びるつぼの浸食を問題と することなく焼成を行うことができる。つまり、仮にこ の条件下で焼成を行った結果、蛍光体中に浸食された窒 化ホウ素が含有した場合であっても、発光輝度を低下さ せることはないため、極めて有用である。実施例6は、 アルミニウムを多く含有させた蛍光体の発光特性を示 す。BNるつぼ以外に、アルミナるつぼを使用した場合

の、アルミナるつぼからの浸食を考慮したものである。 実施例6の結果より、アルミニウムが含有された蛍光体 であっても高い発光特性を示す。これによりアルミナる つぼを使用する場合であっても、アルミナるつぼからの 汚染を問題とすることなく焼成を行うことができる。こ れに対して比較例1は、モリブデンるつぼを使用する。 モリブデンるつぼを使用した場合、るつぼが浸食されモ リブデンが蛍光体中に含有してくる。モリブデンを含有 する比較例1の蛍光体は、発光特性の低下を生じてい る。従って、モリブデンるつぼを使用することはあまり 好ましいとはいえない。Moは発光特性を低下させるた め、系外に除去しておくことが好ましい。 比較例2は、 蛍光体中にFeを含有したものを製造した。 モリブデン るつぼ及び炉からの汚染により、Feが蛍光体中に含ま れる場合もあるため、Feを蛍光体中に含有させたとき の効果を測定した。その結果、Feも発光特性を低下さ せるため、系外に除去しておくことが好ましい。

【0068】<比較試験>本発明の作用効果を明確にするため、さらに比較試験を行った。比較例3は、基本構成元素のみを含有する窒化物蛍光体であるのに対し、実施例1及び4は、基本構成元素及び成分構成元素を含有する窒化物蛍光体である。その結果を、表2に示す。図7は、実施例1及び比較例3の窒化物蛍光体を、Ex=460nmで励起したときの発光スペクトルを示す図である。

【0069】 【表2】

						原料			
	基本構成元素	原料混合比) (Ca/Si/Eu)	Ca ₃ N ₂	Si ₃ N ₄	Eu ₂ O ₃	焼成パターン	るつぼ	雰囲気	ガス流量
比較例3	Ca,,,,Si ₅ N _a :Eu _{0 03}	1.97/5/0.03	2.89	6.95	0.16	2段階 800℃×3h、 1350℃×5h	BN	H ₃ /N ₂	0.1/3
実施例4	Ca _{1,7} Si ₅ N ₀ :Eu _{0 co}	1.97/5/0.03	14.47	34.75	0.79	2段階 800℃×3h、 1350℃×5h	BN	ени	1
実施例1	Ca, , , Si ₅ N ₉ :Eu _{9,00}	1.97/5/0.03	14,47	34.75	0.79	1段階 1350℃×5h	BN	NH3	1

[0070]

			充光特性		温度特性 (%)			
	色調 ×	色調	輝度 (%)	軍子効率	てネルギー効率 (%)	100°C	200°C	300℃
比较例3	0.585	0.407	99.1	100.5	99,1	93.3	62.8	18.2
実施例4	0.584	0.406	128.7	136.8	133,1	97.7	70.6	22.6
実施例1	0.585	0.406	135.5	138.6	138.0	93.7	67.1	23,5

【0071】比較例3の原料の配合比率は、窒化カルシウム Ca_3N_2 : 窒化ケイ素 Si_3N_4 : 酸化ユウロピウム $Eu_2O_3=1$. 97:5:0.03であり、十分に精製を行ったものを使用した。一方、実施例4の原料の配合比率は、比較例3と同条件のものを用い、該原料に実施例1と同濃度のMg、Sr、Ba、Zn、B、Al 、Cu、Mn及びFeを数ppm濃度含有する。実施

例4は、Mn等を含有する3化合物原料を、BNるつばに入れ、室温から徐々に昇温を行い約800℃で3時間、焼成を行い、さらに徐々に昇温を行い約1350℃で5時間、焼成を行い、焼成後、ゆっくりと5時間をかけて室温まで冷却した。比較例3は、Mn等を含有しない3化合物原料をモリブデンるつぼに入れ、水素/窒素雰囲気中で焼成を行った。実施例4のアンモニアの流量

を1とした場合に、比較例3の水素/窒素の流量は、水素:窒素=0.1:3の割合である。一方、実施例1は、アンモニア雰囲気中、徐々に昇温を行い約1350℃で5時間焼成を行い、約5時間かけて室温まで徐々に冷却を行った。

【0072】表2及び図7から明らかなように、比較例 3の発光輝度は、99.1%であるのに対し、実施例4 の発光輝度は、128.7%と、29.6%も発光輝度 が向上した。この発光輝度の違いは、発光効率の観点か ら、極めて重要な意義を持つ。比較例3のエネルギー効 率は、99.1%であるのに対し、実施例4のエネルギ 一効率は、131.1%と、32%も向上した。さら に、比較例3の量子効率は、100.5%であるのに対 し、実施例4の量子効率は、136.8%と、36.3 %も向上した。このように、雰囲気及びるつぼの材質を 変えることにより、極めて顕著な発光特性を得ることが できる。また、Mg、Mn等を含有することにより、極 めて顕著な発光特性を得ることができる。こうした発光 特性の向上は、より鮮やかな白色に発光する発光材料を 提供することができる。また、発光特性の向上は、エネ ルギー効率を高めるため、省電力化も図ることができ る。

【0073】さらに実施例1では、実施例4と比較して焼成パターンの違い以外は、同条件で焼成を行った。実施例1の焼成パターンは、室温から徐々に昇温を行い約1350℃で5時間、焼成を行い、ゆっくりと5時間かけて室温まで冷却した。このとき発光輝度は、135.5%と、比較例3と比べて36.4%も向上した。また、エネルギー効率は、138%と、比較例3と比べて38.9%も向上した。さらに、量子効率は、138.6%と、比較例3と比べて38.1%も向上した。さらに、室温を100として被測定ロットの相対輝度変化で

温度特性を見てみると、比較例3では、温度200℃では62.8%であるのに対し、実施例1は、同温度で67.1%と、高い数値を示した。また300℃では、比較例3の18.2%に対し、実施例1の23.5%と、高い数値を示した。この温度特性は、発光素子の表面に該窒化物蛍光体を設けたとき、窒化物蛍光体の組成が変化せずに、高い発光特性を示しているかを表すものであり、温度特性が高いものほど安定であることを示している。表2の結果から本発明に係る窒化物蛍光体の方が、比較例3よりも温度特性が良好であり、信頼性が高いことが明確である。このように、実施例1及び4は、比較例3と比べて極めて顕著な発光特性を示した。これにより従来解決されていなかった発光特性の向上を、極めて容易に図ることができる。

【0074】<実施例7~9>実施例7は、蛍光体の基本構成元素がSr_{1.97}Eu_{0.03}Si₅N₈である。原料の配合比率は、窒化カルシウムSr₃N₂:窒化ケイ素Si₃N₄:酸化ユウロピウムEu₂O₃=1.97:5:0.03である。この原料中には、Mg、Sr、Ba、Zn、B、Al、Cu、Mn、Co及びFeが250~400ppm濃度含有されている。この3化合物原料を、BNるつばに入れ、管状炉で、800~1000℃で3時間焼成し、その後、1250~1350℃で5時間焼成を行い、5時間かけて室温まで、徐々に冷却を行った。アンモニアガスは、11/minの割合で、終始流し続けた。この結果、実施例7の窒化物蛍光体の200℃における温度特性は、87.7%と極めて高い温度特性を示している。表3は、本発明に係る窒化物蛍光体の実施例7~9を示す。

【0075】 【表3】

		原料							
	基本構成元素	原料混合比	焼成パターン	雰囲気	るつぼ 材質	原料(g)			
突施例7	Sr _{1.97} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.03}	Sr/Si/Eu =1.97/5/0.03	2段階 800~1000℃×3h、 1250~1350℃×5h	NH ₃	BN	4.47			
実施例8	Sr, 4Ca _{0,6} Si ₈ N ₈ :Eu	Sr/Ce/Si/Eu =1.26/0,54/5/0.2	2段階 800~1000℃×3h、 1250~1350℃×5h	, NH ³	BN	8.8			
突施例9	Sr, 4Ca _{0 4} Si ₆ N ₄ :Eu	Sr/Ca/Si/Eu =1.379/0.591/5/0.03	2段階 800~1000℃×3h、 1250~1350℃×5h	NH ₂	BN	8.8			

[0076]

			温度特性 (%)			
	色調	色調	輝度 (%)	量子効率 (%)	ピーク波長 (nm)	200°C
実施例7	0.612	0.379	96.5	110.2	. 621	87.7
実施例8	0.649	0.341	58.8	151.9	657	92.3
实施例9	0.655	0.386	89.9 .	119.5	637	97.9

【0077】実施例8は、蛍光体の基本構成元素は $Sr_{1.4}$ $Ca_{0.6}$ Si_{5} N_{8} : Euv Ta_{8} Ev Ta_{8} Ta_{8} Ev Ta_{8} Ta_{8}

た、実施例8の蛍光体 $Sr_{1.4}$ $Ca_{0.6}$ Si_{5} N_{8} : Euの量子効率は、151.9%と、極めて良好である。

【0078】実施例9は、Euの配合割合を変えたものである。実施例9も他の実施例と同様、良好な発光特性を示す。またEu濃度を変えることにより発光波長は637nmとなる。温度特性は、200℃で97.9%と高い数値を示していることから、高安定性を示す。

【0079】<実施例10乃至20>実施例10乃至20は、残光性の測定を行った。表4は、実施例10乃至20の残光性を測定した結果を示す。図9は、実施例10の残光性を測定した測定結果を示す。

[0080].

【表4】

	基本構成元素	化合物	添加 (wt%)	1/10残光 (msec)
添加物なし	Ca _{1.94} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.06}	_		20.5
实施例10	Ca _{1.94} Si ₅ N ₁ :Fu _{0.06}	BN	0.25	6.5
実施例11	Ca _{1.94} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.05}	BN	0.75	14.5.
实施例12	Ca _{1.94} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.06}	BN	1,50	16.5
実施例13	Ca _{1.84} Si ₅ N ₉ :Eu _{0.06}	BN	3.00	18.0
英施例14	Ca _{1.94} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.06}	Н₀ВО₃	0.25	10.5
実施例15	Ca _{1.94} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.00}	H ₃ BO ₃	. 0.75	9.5
実施例16	Ca _{1,94} Si ₅ N ₈ :Eu _{0,06}	H ₃ 80 ₃	1.50	13.0
実施例17	Ca _{1.54} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.05}	Н₃ВО₃	3.00	18.5
実施例18	Ca _{1.64} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.00}	ME ₃ N ₂	0.05	7.0
実施例19	Ca _{1.84} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.06}	Mg ₃ N ₂	0.10	11.0
宾施例20	Ca _{1.34} Si ₅ N ₈ :Eu _{0.06}	Mg ₃ N ₂	0.20	14.5

【0081】実施例10万至20の測定は、254nmの紫外線を照射し、照射を停止した直後の発光強度を1とする。照射を停止した直後から発光強度が1/10になるまでの時間を測定する。表4は、発光強度が1/10にまるまでに要した時間である。実施例10万至20は、実施例1の蛍光体と添加物を除き同組成である。つまり、蛍光体の基本構成元素がCa_{1.97}Eu

 施例 18 乃至 20 は M g_3 N_2 を、所定の配合量使用する。比較対照として添加物を含有していない蛍光体を基準値に用いた。その結果、残光は実施例 10 乃至 13 のうち実施例 10 が最も短かった。実施例 14 乃至 17 では、実施例 14 が最も短かく、実施例 18 乃至 20 では、実施例 18 も最も短かった。このように、18 のように、18 を所定量添加することにより、残光特性を抑えることができる。

【0083】窒化物蛍光体の基本構成元素は、Sr2S i₅ N₈: Eu, Ba₂ Si₅ N₈: Eu, Mg₂ Si 5 N₈: Eu, Zn₂ Si₅ N₈: Eu, SrSi₇ N $_{1\ 0}$: Eu, BaSi $_{7}$ N $_{1\ 0}$: Eu, MgSi $_{7}$ N $_{1\ 0}:$ Eu, $Z\,n\,S\,i_{\,7}\,N_{1\ 0}:$ Eu, $S\,r_{\,2}\,G\,e_{\,5}\,N$ 8: Eu, Ba₂ Ge₅ N₈: Eu, Mg₂ Ge 5 N₈ : Eu, Zn₂ Ge₅ N₈ : Eu, SrGe₇ N 10: Eu, BaGe7 N₁₀: Eu, MgGe7 N 10: Eu, ZnGe7 N₁₀: Eu, Sr₁₈ Ca 0. 2 Si₅ N₈: Eu, Ba_{1.8} Ca_{0.2} Si₅ N₈: Eu, Mg_{1.8} Ca_{0.2} Si₅ N₈: Eu, Zn_{1.8}Ca_{0.2}Si₅N₈: Eu, Sr_{0.8}C a_{0.2} Si₇ N₁₀: Eu, Ba_{0.8} Ca_{0.2} S $i_7 \, N_{10}$: Eu、 $Mg_{0.8} \, Ca_{0.2} \, Si$ $_{7}\,N_{1\,\,0}$: Eu, $Z\,n_{0\,\,.\,\,8}\,C\,a_{0\,\,.\,\,2}\,S\,i_{\,7}\,\dot{N}_{1\,\,0}$: Eu , $\operatorname{Sr}_{0.~8}\operatorname{Ca}_{0.~2}\operatorname{Ge}_7\operatorname{N}_{1.0}:\operatorname{Eu}$, Ba o. 8 Ca_{0. 2} Ge₇ N₁₀ : Eu, Mg_{0.8} Ca 0. 2 Ge 7 N 1 0 : Eu . Zn 0 . 8 Ca 0 . 2 Ge 7 N₁₀: Eu, Sr_{0.8} Ca_{0.2} Si₆ GeN 10: Eu, Bao. 8 Cao. 2 Si 6 Ge N 10: Eu, $Mg_{0.8}Ca_{0.2}Si_6GeN_{10}:Eu$, Zn_{0.8}Ca_{0.2}Si₆GeN₁₀:Eu、Sr₂ $Si_5N_8:Pr$, $Ba_2Si_5N_8:Pr$, Sr_2S i₅ N₈:Tb、BaGe₇ N₁₀:Ceなどが製造で きる。但し、本発明は、この窒化物蛍光体に限定される ものでない。

【0084】 <発光装置1>図10は、本発明に係る発 光装置1を示す図である。

【0085】発光層として発光ピークが背色領域にある 460nmのInGaN系半導体層を有する半導体発光 素子101を用いる。該半導体発光素子101には、p 型半導体層と n型半導体層とが形成されており (図示し ない)、該p型半導体層とn型半導体層には、リード電 極102へ連結される導電性ワイヤ104が形成されて いる。リード電極102の外周を覆うように絶縁封止材 103が形成され、短絡を防止している。半導体発光素 子101の上方には、パッケージ105の上部にあるリ ッド106から延びる透光性の窓部107が設けられて いる。該透光性の窓部107の内面には、本発明に係る 窒化物蛍光体108及びコーティング部材109の均一 混合物がほぼ全面に塗布されている。発光装置1では、 実施例1の窒化物蛍光体を使用する。パッケージ105 は、角部がとれた一辺が8mm~12mmの正方形であ る。

【0086】半導体発光素子101で青色に発光した発 光スペクトルは、反射板で反射した間接的な発光スペク トルと、半導体発光素子101から直接射出された発光 スペクトルとが、本発明の窒化物蛍光体108に照射さ れ、白色に発光する蛍光体となる。本発明の窒化物蛍光 体108に、緑色系発光蛍光体SrAl₂O₄:Eu、 Y₂ SiO₅: Ce, Tb, MgAl₁₁O₁₉: C e, Tb, Sr7 Al₁₂O₂₅: Eu, (Mg, C a、Sr、Baのうち少なくとも1以上)Ga2S4: Eu、青色系発光蛍光体Sr₅ (PO₄)₃ Cl:E $u \cdot (SrCaBa)_5 (PO_4)_3 C1 : Eu \cdot (B$ aCa) $_5$ (PO $_4$) $_3$ Cl:Eu、(Mg、Ca、S r、Baのうち少なくとも1以上)₂B₅O₉C1:E u, Mn、(Mg、Ca、Sr、Baのうち少なくとも 1以上) (PO₄)₆ Cl₂: Eu, Mn、赤色系発光 蛍光体Y₂O₂S:Eu、La₂O₂S:Eu、Y₂O 3:Eu、Ga2O2S:Euなどをドープすることに より、所望の発光スペクトルを得ることができる。

【0087】以上のようにして形成された発光装置を用いて白色LEDランプを形成すると、歩留まりは99%である。このように、本発明である発光ダイオードを使用することで、量産性良く発光装置を生産でき、信頼性が高く且つ色調ムラの少ない発光装置を提供することができる。

【0088】 <発光装置2>図1は、本発明に係る発光 装置2を示す図である。図11は、本発明に係る発光装置2の発光スペクトルを示す図である。図12は、本発明に係る発光装置2の色度座標を示す図である。

【0089】発光装置2は、サファイア基板1上にn型及びp型のGaN層の半導体層2が形成され、該n型及びp型の半導体層2に電極3が設けられ、該電極3は、導電性ワイヤ14によりリードフレーム13と導電接続されている。半導体発光素子10の上部は、蛍光体11及びコーティング部材12で覆われ、リードフレーム1

3、蛍光体11及びコーティング部材12等の外周をモ ールド部材15で覆っている。半導体層2は、サファイ ア基板1上にn+GaN:Si、n-AlGaN:S i, n-GaN, GaInN QWs, p-GaN:M g、p-AlGaN:Mg、p-GaN:Mgの順に積 層されている。該n+GaN:Si層の一部はエッチン グされてn型電極が形成されている。該p-GaN:M g層上には、p型電極が形成されている。リードフレー ム13は、鉄入り銅を用いる。マウントリード13aの 上部には、半導体発光素子10を積載するためのカップ が設けられており、該カップのほぼ中央部の底面に該半 導体発光素子10がダイボンドされている。 導電性ワイ ヤ14には、金を用い、電極3と導電性ワイヤ14を導 電接続するためのバンプ4には、Niメッキを施す。蛍 光体11には、実施例1の窒化物蛍光体とYAG系蛍光 体とを混合する。 コーティング部材12には、エポキシ 樹脂と拡散剤、チタン酸バリウム、酸化チタン及び前記 蛍光体11を所定の割合で混合したものを用いる。 モー

ルド部材15は、エポキシ樹脂を用いる。この砲弾型の 発光装置2は、モールド部材15の半径2~4mm、高 さ約7~10mmの上部が半球の円筒型である。発光装 置2に電流を流すと、おおよそ460 nmで励起する第 1の発光スペクトルを有する青色半導体発光素子10が 発光し、この第1の発光スペクトルを、半導体層2を覆 う窒化物蛍光体11が色調変換を行い、前記第1の発光 スペクトルと異なる第2の発光スペクトルを有する。ま た、蛍光体11中に含有されているYAG系蛍光体は、 第1の発光スペクトルにより、第3の発光スペクトルを 示す。この第1、第2及び第3の発光スペクトルが互い に混色となり赤みを帯びた白色に発光する発光装置2を 提供することができる。表5は、本発明に係る発光装置 2の発光特性を示す。図12、表5は、本発明に係る発 光装置2の比較対象として、YAGの蛍光体を用いた発 光装置の測定結果も併せて示す。

【0090】 【表5】

	電商 IF (mA)	電圧 VF (V)	放射分析 Radiometric (mW)	光度測定 Photometric (Im)	ピーク変長 Peak (nm)	半値領 FWHM (pm)	投波長 Dominant (nm)
着色LED	20	4.05	14.7B	. 0.955	464.02	19.35	468.05
#ELED HYAG	20	3.75	9.59	3.042	463.47	150.73	568.85
T色LFD計算化物量 光体8a	20	3.80	5.84	1.8,90	596.00	196.36	582.75

[0091]

	色調	色調	色温度 Tcp (K)	平均演色性 Ra	発光効率 (Im/W)
青色LED	0.134	0.057	-	_	11.8
常色LED+YAG	0.348	0.367	4939	78.3	40.6
青色LED+YAG+ 窒化物蛍光体(実施例1)	0.454	0.416	2928	76.0	24.9

【0092】本発明に係る発光装置2の窒化物蛍光体は、実施例1の窒化物蛍光体と、コーティング部材12と、セリウムで付活されたYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)蛍光物質とを混合した蛍光体11を用いる。これら蛍光体11の重量比は、コーティング部材:YAG:実施例1の窒化物蛍光体=25:6:3である。一方、青色半導体発光素子とYAGの蛍光体との組み合わせの発光装置の蛍光体は、コーティング部材:YAG=25:6の重量比で混合している。

【0093】本発明に係る発光装置2と、青色半導体発光素子及びYAGの蛍光体とを用いた発光装置とを比較する。このYAGの蛍光体は、ピーク波長が463.47nmであるのに対し、窒化物蛍光体のピーク波長は、596.00nmと異なる位置に発光スペクトルを有している。色度座標においても、YAGの蛍光体のみを用いた発光装置は、色調x=0.348、色調y=0.367で表され比較的青白く発光する白色である。一方、YAG系蛍光体と窒化物蛍光体とを用いた発光装置2

は、色調x=0.454、色調y=0.416で表される赤みを帯びた白色である。色温度は、2827.96 K、演色性Raは、76であり、電球色に近い発光特性を有している。また、本発明に係る発光装置2は、24.871 m/Wという高い発光効率を有している。このことから、電球色に近い発光装置を製造することができるという極めて重要な技術的意義を有する。

[0094]

【発明の効果】従って、本発明は、第1の発光スペクトルの一部を変換し、第1の発光スペクトルと異なる領域に第2の発光スペクトルを有する発光輝度の高い蛍光体を提供すること、具体的には、光源に紫外から背色領域の発光スペクトルを有する半導体発光素子を使用し、該半導体発光素子からの発光スペクトルを色調変換し、やや赤みを帯びた暖色系の白色に発光する発光特性の優れた蛍光体を提供することができる。また、残光が短い蛍光体を提供することができる。さらに、青色半導体発光素子と該蛍光体とを組み合わせて白色に発光する発光装

置を提供することができる。

【0095】本発明は、蛍光表示管、ディスプレイ、PDP、CRT、FL、FED及び投写管等、特に、青色発光ダイオード又は紫外発光ダイオードを光源とする発光装置、店頭のディスプレイ用の照明、医療現場用の照明などの蛍光ランプに使用することができる。その他、携帯電話のバックライト、発光ダイオード(LED)の分野などにも応用することができる。このように、本発明は、従来解決されなかった課題を解決するものであり、極めて優れた技術的意義を有する。

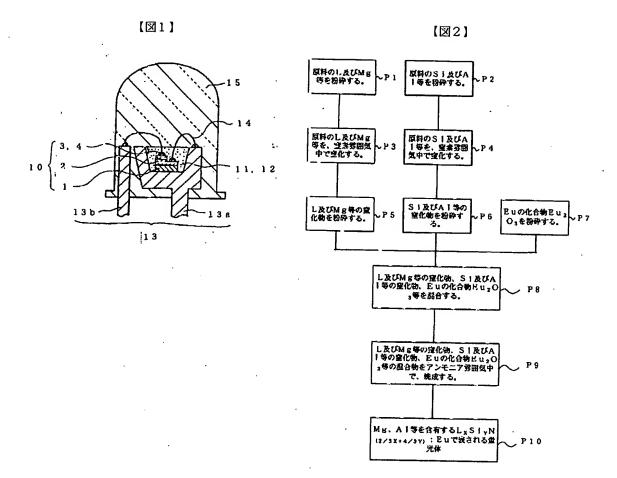
【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明に係る発光装置2を示す図である。
- 【図2】 本発明に係る窒化物蛍光体の製造方法を示す 図である。
- 【図3】 実施例2及び3の窒化物蛍光体をEx=46 Onmで励起したときの発光スペクトルを示す図である。
- 【図4】 実施例2及び3の窒化物蛍光体の励起スペクトルを示す図である。
- 【図5】 実施例2及び3の窒化物蛍光体の反射スペクトルを示す図である。
- 【図6】 実施例3の窒化物蛍光体の粒径を撮影した写真である。
- 【図7】 実施例1及び比較例3の窒化物蛍光体を、E x=460nmで励起したときの発光スペクトルを示す図である。
- 【図8】 実施例8の窒化物蛍光体をEx=460nm で励起したときの発光スペクトルを示す図である。
- 【図9】 実施例10の残光性を測定した測定結果を示す図である。
- 【図10】 本発明に係る発光装置1の発光スペクトルを示す図である。
- 【図11】 本発明に係る発光装置2の発光スペクトルを示す図である。
- 【図12】 本発明に係る発光装置2の色度座標を示す図である。

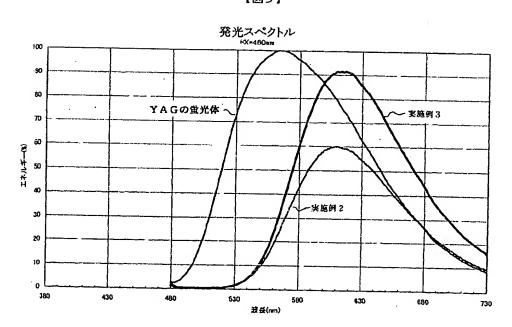
【符号の説明】

P1 原料のL及びMg等を粉砕する。

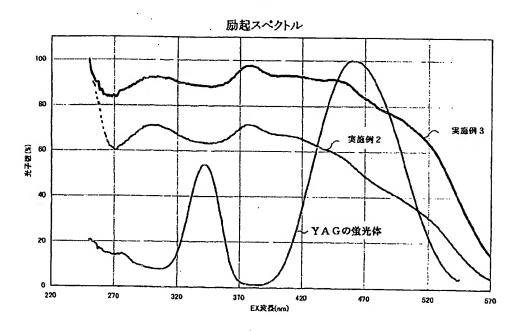
- P2 原料のSi及びAl等を粉砕する。
- P3 原料のL及びMg等を、窒素雰囲気中で窒化す
- る。
- P4 原料のSi及びAl等を、窒素雰囲気中で窒化
- する。
- P5 L及びMg等の窒化物を粉砕する。
- P6 Si及びAI等の窒化物を粉砕する。
- P7 Euの化合物Eu₂O₃を粉砕する。
- P8 L及びMg等の窒化物、Si及びAl等の窒化物、Euの化合物Eu₂O₃等を混合する。
- P9 L及びMg等の窒化物、Si及VAl等の窒化物、Euの化合物Eu $_2O_3$ 等の混合物をアンモニア雰囲気中で、焼成する。
- P10 Mg、Al等を含有する $L_X Si_Y N$ (2/3X+4/3Y): Euで表される蛍光体を得ることができる。
- 1 基板
- 2 半導体層
- 3 電極
- 4 バンプ
- 10 半導体発光素子
- 11 蛍光体
- 12 コーティング部材
- 13 リードフレーム
- 13a マウントリード
- 13b インナーリード
- 14 導電性ワイヤ
- 15 モールド部材
- 101 半導体発光素子
- 102 リード電極
- 103 絶縁封止材
- 104 導電性ワイヤ
- 105 パッケージ
- 106 リッド
- 107 窓部
- 108 蛍光体
- 109 コーティング部材



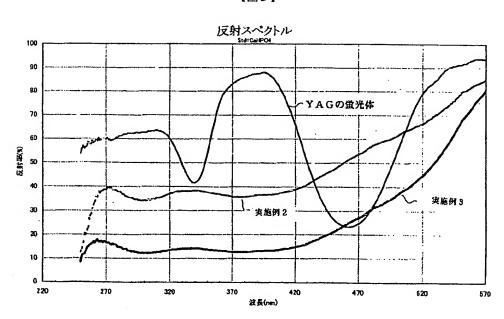
【図3】



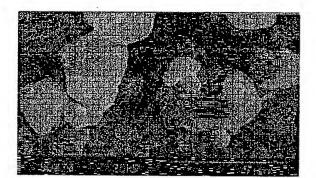
【図4】



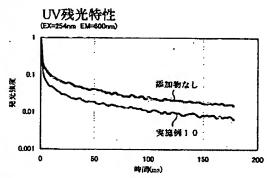
【図5】



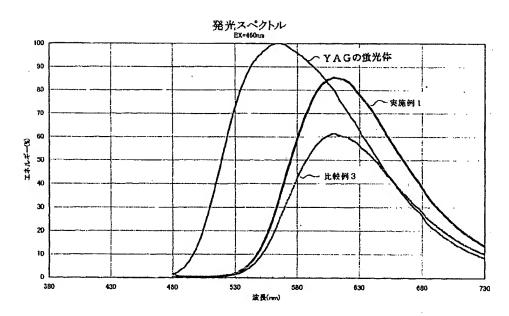
【図6】



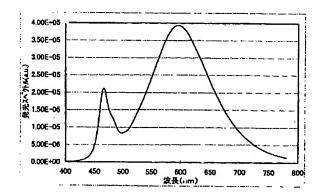
【図9】



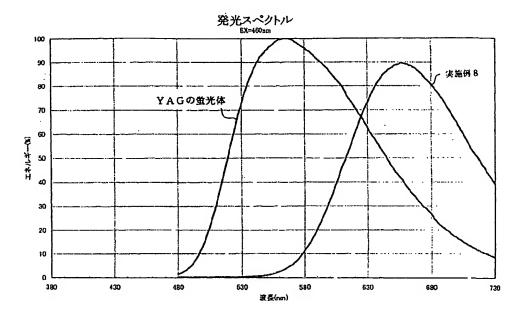
【図7】



【図11】

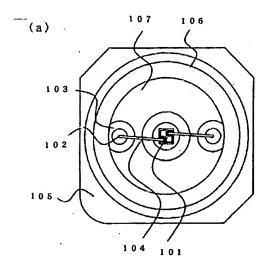


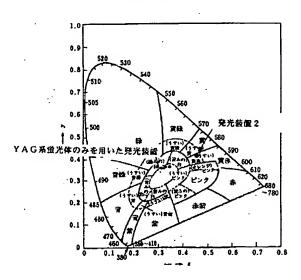
【図8】

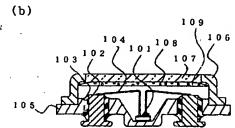


【図10】

【図12】







フロントページの続き

(51) Int. Cl . ⁷		識別記号	FI			(参考)
C09K	11/66	CQF	C09K	11/66	CQF	
	11/67	CPM		11/67	CPM	
	11/80			11/80		
H01L	33/00		H01L	33/00	N	

F ターム(参考) 4H001 CA04 CA05 CA07 CF02 XA03 XA04 XA05 XA06 XA07 XA08 XA11 XA12 XA13 XA14 XA19 XA20 XA22 XA24 XA25 XA26 XA28 XA29 XA30 XA31 XA32 XA37 XA38 XA39 XA40 XA42 XA48 XA49 XA50 XA56 XA72 XA80 YA00 YA24 YA25 YA51 YA58 YA63 YA82 SF041 AA03 AA11 AA43 CA05 CA12 CA40 CA46 CB36 DA12 DA16 DA19 DA43 DA55 DA56 DA57

FF16

DA75 DB02 DB04 EE25 FF11